

а 2000 0106

Изобретение относится к фотоприемникам на основе полупроводников, в частности к приемникам ультрафиолетового излучения, и может быть использовано в оптоэлектронных системах для определения интенсивности и дозы ультрафиолетового излучения Солнца или других источников света.

Сущность изобретения состоит в том, что фотоприемник ультрафиолетового излучения на основе структур с поверхностным потенциальным барьером содержит слой из полупроводников А^{III}В^V, тунельно - прозрачный слой собственного окисла и слой из SnO₂ или ITO, причем в полупроводниковом слое А^{III}В^V сформирован дефектный слой, в котором время жизни неосновных носителей электрического заряда минимально. Дефектный слой расположен на расстоянии от поверхности полупроводникового слоя не больше глубины поглощения видимого излучения.